

中国半导体行业协会半导体分立器件分会

中半器协 [2016]007 号

第二届全国新型半导体功率器件及应用技术研讨会

第二轮通知

自 2016 年 7 月 1 日中国半导体行业协会以“中半器协[2016]003 号”文发出《第二届全国新型半导体功率器件及应用技术研讨会》以来，来自全国各地的产、学、研等单位大力支持，积极投稿，现会议的准备工作的已经就绪，就会议细节和论文录用情况通知如下：

畅通、共享、共赢——全球化背景下的新型半导体器件及应用技术

一、会议特邀报告

1. 后 IGBT 时代的机遇与挑战

株洲中车时代电气股份有限公司副总工程师 刘国友 教授

2. GaN 基功率电子器件的研究进展与技术挑战

南京大学电子科学与工程学院 陆海 教授

3. IGBT 技术发展的里程碑

英飞凌科技中国有限公司工业功率控制事业部高级经理 陈子颖 先生

4. Shield-gate MOS 器件的技术进展及主流厂家技术对比

电子科技大学微电子与固体电子学院 李泽宏 教授

5. 氮化镓功率器件发展和应用面临的若干问题

专用集成电路重点实验室副主任 冯志红 研究员

6. 碳化硅单晶衬底发展与展望

北京天科合达蓝光半导体有限公司常务副总经理兼技术总监 彭同华 研究员

7. 针对 GW 级 VSC-HVDC 应用的大功率器件及 StakPak 模块的发展趋势及现状

瑞士 ABB 公司半导体高级销售经理 陈马看 博士

二、会议组织机构

指导单位：中国半导体行业协会

承办单位：中国半导体行业协会半导体分立器件分会

专用集成电路重点实验室

中国电子科技集团公司第十三研究所

协办单位：合肥锐拓科技信息服务有限公司

云南妙创会议服务有限公司

《半导体技术》编辑部

《微纳电子技术》编辑部

三、会议地点：昆明云安会都温泉大酒店

昆明市西山区石安公路马街路口。机场至云安会都距离约 35 公里，打车需 50 分钟。也可选乘机场大巴可选乘 2 号线或 919C 公交，至火车站下车，再乘坐出租车或 51 路公交前往。距离昆明站约 10 公里，公交车 51 路车到云安会都站下车即到。距昆明西站约 1.3 公里。

四、会议日程

1. 此次《研讨会》共录用论文（或论文摘要）120 篇（见附件），其中特邀报告 7 篇，全部特邀报告和论文摘要（或论文）都已经收入《论文集》，并将在参会者到会注册时发给每位参会者。希望每篇论文摘要（或论文）至少有一位作者参加会议。

由于研讨会时间有限，我们将根据具体情况选择安排在会上作报告的论文，并在会前与作者沟通。

2. 11 月 25 日在昆明云安会都温泉大酒店报到，11 月 26-27 日开会。会议议程安排如下：

时 间	地 点	主 题
11 月 26 日上午	云安会堂四楼 2 号会议室	开幕式；特邀报告
11 月 26 日下午		特邀报告；大会报告
11 月 27 日上午		大会报告
11 月 27 日下午		大会报告

3. 11 月 28 日机动。

会议联系单位：中国半导体行业协会半导体分立器件分会秘书处

（石家庄市合作路 113 号 中国电子科技集团公司第十三研究所）

联系人：陆 皓 手机：13832163057 电子邮件：luhao4168@vip.126.com

李 永 电话：0311-87091519 手机：13933075237

传 真：0311-87091477

电子邮件：polaris13@vip.163.com

半导体分立器件分会信箱：csiadd@126.com

中国半导体行业协会半导体分立器件分会

二零一六年十月二十八日



附件一：研讨会录用论文摘要（或论文）目录 （按论文摘要收录时间为序）

序号	作者姓名	工作单位	论文题目
1	李文铨	南京工业大学	对不同结构样式 LED 散热器的对比选用方法
2	苏昱太	北京航空航天大学	基于失效物理的 IGBT 焊料层热疲劳可靠性评价方法研究
3	张兴尧	中国科学院新疆理化技术研究所	InP/InGaAs DHBTs 和 InP 基分频器的位移效应
4	徐君	阳光电源中央研究院电力电子研究所	SiC 器件在光伏逆变器中的应用
5	钟伟	南京大学	单层 MoS ₂ 量子点的合成、光学与析氢催化性能
6	翟玉卫	中国电子科技集团公司第十三研究所	GaN 器件毁伤实验温度测量用高速红外测温装置
7	刘永建	成都信息工程大学通信工程学院	ZnO 薄膜的制备及温度影响研究
8	尤欢	成都信息工程大学通信工程学院	基于 0.18 μ m CMOS 工艺的数字混频器的设计与仿真
9	周瑞	成都信息工程大学通信工程学院	激光线宽对三能级原子系统相干效应的影响
10	陈俊	重庆中科渝芯电子有限公司	Bonding SOI 材料应力控制技术研究
11	李加杰	哈尔滨工业大学	氮化碳原位制备氮掺杂石墨烯及其在非金属氧还原催化方面的应用
12	郭宇锋	南京邮电大学	SOI 横向功率器件的衬底效应
13	殷玉喆	工业和信息化部电子工业标准化研究院	偏置集成型百瓦级中大功率固态器件测试夹具的研制
14	马秀雯	中国科学院半导体研究所	基于回音壁耦合微腔的单模高速激光器
15	范让萱	上海华虹宏力半导体制造有限公司	一种新型屏蔽栅沟槽 MOSFET 结构和工艺
16	孔岑	中国电子科技集团公司第五十五研究所	低比导电阻增强型 GaN HEMT 功率电子器件
17	李飞	杭州电子科技大学	基于 BSIMSOI、PSPSOI、BSIMIMG 的 RFSOIMOSFET 建模分析
18	陈志勇	南京国博电子有限公司	n3.5GHz 225W GaN Doherty 功放设计
19	高志远	北京工业大学	用耗散结构理论解释 GaN 的 MOCVD 生长及表面微结构特征
20	赵曼	长春理工大学理学院	基于局域表面等离激元增强的 MgZnO 紫外光电探测器研究
21	赵丽丽	哈尔滨化兴软控科技有限公司	基于 TaC 坩埚的 PVT 法大尺寸 SiC 晶体生长
22	南敬昌	辽宁工程技术大学电信学院	高效、宽带双频与高线性功放设计理论及方法研究
23	高勇	西安理工大学电子工程系	半超结功率开关二极管
24	肖龙飞	山东大学晶体材料研究所	多层光学薄膜对于砷化镓光导开关导通电阻的影响
25	王琦楠	南京邮电大学	HVPE 生长的高质量 GaN 纳米线的光学性质研究

- 26 董琛 南京邮电大学 PVT 生长 GaN 纳米线的仿真与实验研究
- 27 王荣欣 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 p-GaN 金半接触的研究
- 28 孙世闯 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 P-GaN 作为电流阻挡层的垂直结构 AlGaIn/GaNHEMT 的 MOCVD 外延生长与器件研究
- 29 宋亮 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 基于 LPCVD-SiN_x 优化的低电流崩塌 AlGaIn/GaN HEMT
- 30 付凯 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 基于 H 等离子体处理实现增强型 p-GaN/AlGaIn/GaN HEMT 的研究
- 31 蒋春萍 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 高温大功率器件 P-GaN 欧姆接触的研究
- 32 任国强 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 氮化镓体单晶生长
- 33 徐俞 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 非掺杂氮化物材料光电导现象及其机理分析
- 34 贾一凡 西安电子科技大学微电子学院 4H-SiC MOS 器件的电压应力可靠性研究分析
- 35 赵钧 北京斯莫科技股份有限公司 三维高性能大功率电子器件散热技术
- 36 高秀秀 厦门元顺微电子有限公司 500~900V 超结 MOS 功率器件的制造
- 37 王仲康 北京中电科电子装备有限公司 分立器件晶圆减薄技术研究
- 38 叶乐志 北京中电科电子装备有限公司 高精度倒装键合机热误差补偿技术研究
- 39 黄铭敏 四川大学物理科学与技术学院 电荷补偿型垂直导电功率 MOSFET 的研究进展
- 40 方子文 Aixtron China 实现 GaN 与 SiC 功率器件产业化生产的外延技术
- 41 姜贸公 北京航空航天大学 基于电热关系的固态微波功率器件焊接缺陷影响研究
- 42 赵敏 军械工程学院 场敏感型自适应电磁防护材料的测试装置与方法研究
- 43 陈欣 东南大学 主流 1.2kV SiC 功率 MOSFET 产品高温特性比较及物理解
- 44 刘一婷 沈阳工业大学 Enhanced photocurrent spectral response range in the bulk heterojunction solar cells
- 45 赵小红 西安电子科技大学 质子辐照对 InP / InGaAs 异质结特性的影响
- 46 李少军 西安电子科技大学 一款基于 GaAs HBT 工艺 8 GS/s 采样率的宽带跟踪保持放大器
- 47 朱莉 西安电子科技大学 基于改善 InGaP/GaAs 自热效应的复合管结构
- 48 张艳松 西安电子科技大学 W 波段 InP HEMT 功率放大器设计
- 49 彭朝阳 中国科学院微电子研究所 退火温度对 SiC/SiO₂ 界面氮化机制的影响研究
- 50 陈宏 中国科学院微电子研究所 SiC 肖特基二极管可靠性及失效分析研究
- 51 胡飞 中国科学院微电子研究所 MOS 控制晶闸管 (MCT) 的概述与发展展望
- 52 田晓莉 中国科学院微电子研究所 SiC IGBT 技术发展概述
- 53 王斌 西安电子科技大学 一种新型“面隧穿” Ge 基 TFET 器件的设计与分析
- 54 马涤非 中山德华芯片技术有限公司 晶格匹配的五结 GaAs 太阳能电池研制

- 55 王路璐 北京中科新微特科技开发股份有限公司 功率半导体器件长期贮存可靠性研究
- 56 方杰 新型功率半导体器件国家重点实验室 新能源用1700V/450A 高功率密度IGBT模块的研制
- 57 陈勇民 新型功率半导体器件国家重点实验室 5000A/4500V 非对称型IGCT器件的研究
- 58 沈国策 中国电子科技集团公司第五十五研究所 一种X波段MEMS微带贴片天线的设计
- 59 薛爱杰 中国电子科技集团公司第五十五研究所 6500V 15A 4H-SiC JBS 二极管的研制
- 60 赵耿 株洲中车时代电气股份有限公司 关于晶闸管关断过程中电流跳变的调查研究
- 61 常桂钦 株洲中车时代电气股份有限公司 基于有限元的IGBT器件疲劳寿命仿真分析
- 62 刘雅岚 新型功率半导体国家重点实验室 超声扫描在双极器件烧结空洞检测中的应用
- 63 赵昭 工业和信息化部电子工业标准化研究院 半导体霍尔系数测试仪的校准和不确定度分析
- 64 廖淋圆 湖南大学 基于1200V/6A SiC BJT 达林顿结构的高效逆变器
- 65 李婷 上海交通大学 掺杂TiO₂纳米管光解水制氢性能研究
- 66 王金延 北京大学 AlGa_N/Ga_N 自停止热氧化辅助湿法腐蚀工艺、原理及应用
- 67 张波 电子科技大学 基于GaAs的单片集成倍频源研究
- 68 李欣 天津大学 纳米银焊膏烧结大功率LED模块的寿命预测
- 69 陈永和 桂林电子科技大学 氮化硅淀积工艺对薄势垒层铝镓氮/氮化镓高电子迁移率晶体管的影响
- 70 谷文萍 长安大学 中子辐照对Ga_N基HEMT器件的影响研究
- 71 徐小波 长安大学 Zn组分对CdTe_{1-x}S_x太阳能电池的影响研究
- 72 孟华群 中国电子科技集团公司第二十四研究所 一种高压PIN开关驱动器及检测器的设计
- 73 郭春生 北京工业大学 工作条件下IGBT结温实时测量方法的研究
- 74 李悦文 南京大学 升华法在石墨烯上外延Ga_N纳米线
- 75 徐辉 浙江工业大学 高迁移率n型纳米金刚石薄膜研究
- 76 万彩萍 北方工业大学 NO退火对SiC MOS器件栅氧化层可靠性影响研究
- 77 郑柳 全球能源互联网研究院功率半导体研究所 4H-SiC中Al离子注入及二次高温退火技术研究
- 78 桑玲 全球能源互联网研究院功率半导体研究所 6500V 4H-SiC MOSFET的元胞结构设计与特性仿真
- 79 夏经华 全球能源互联网研究院功率半导体研究所 N型/P型4H-SiC同时形成欧姆接触
- 80 查祎英 全球能源互联网研究院功率半导体研究所 基于厚膜外延的SiC JBS二极管试制
- 81 王嘉铭 全球能源互联网研究院功率半导体研究所 金刚石在未来电网中的应用展望
- 82 刘成 三安集成电路有限公司氮化镓技术开发处 高稳定性600V/10A氮化镓基功率器件的开发
- 83 齐臣杰 北京信息科技大学 三维径向纳米ZnO太阳能电池制备研究
- 84 姚博 绍兴文理学院 采用漏电流输运机制研究Al(Pt)/Tm₂O₃/Si的能带结构

- 85 冯晶 昆明理工大学 强关联氧化物超高温铁弹电子材料 YTaO₄ 的高温相变与热学性质
- 86 刘章发 北京交通大学 一种输出可调的 LDO 线性稳压器的设计
- 87 丰豪 湖北大学 基于电流模电路的大功率宽带电流放大器的设计与仿真
- 88 何静远 河南工业大学 金刚石在电子元器件封装材料中的应用
- 89 王宏智 中国电子科技集团公司第四十五研究所 国产碳化硅 (SiC) 功率器件制造设备发展现状和机遇分析
- 90 王锋 苏州英诺迅科技股份有限公司 热分流式微波功率放大器优化设计
- 91 王文娟 工业和信息化部电子工业标准化研究院 固态微波功率器件测量夹具及其校准技术研究
- 92 陈骞 西安卫光科技有限公司 600V 高压 VDMOS 的设计
- 93 陈骞 西安卫光科技有限公司 一种改善管芯表面质量的工艺研究
- 94 闫磊 西安卫光科技有限公司 MOS 器件稳态总剂量试验研究
- 95 刘琦 西安卫光科技有限公司 VDMOS 器件终端结构的优化
- 96 丁文华 西安卫光科技有限公司 槽栅 VDMOS 器件结构与设计研究
- 97 赵延峰 西安卫光科技有限公司 浅谈半导体器件的静电危害及防护
- 98 习毓 西安卫光科技有限公司 高压超结 VDMOS 研究
- 99 赵振富 宁波大学 极性调控 GaN 纳米线压电电子学性质的研究
- 100 王刚 宁波大学 利用离子注入技术制备层数可控和带隙可控的石墨烯
- 101 王信 中国科学院新疆理化技术研究所 国产 N 沟 VDMOS 器件的总剂量辐射损伤效应研究
- 102 浦诗睿 电子科技大学 大功率 GaN 器件高效散热用金刚石热扩散器设计与热仿真研究
- 103 刘源 瑞能半导体有限公司 碳化硅二极管晶圆及封装工艺优化
- 104 轩雪飞 杭州电子科技大学 宽带 F 类功率放大器
- 105 白丕绩 昆明物理研究所 数字化中波红外焦平面探测器组件研究进展
- 106 都时禹 哈尔滨工程大学 低维材料 MXene 的电子结构及关键物理性质的理论预测
- 107 唐利斌 昆明物理研究所 石墨烯基光电材料及器件研究进展
- 108 周旭昌 昆明物理研究所 III-V 族低维结构红外探测器研究
- 109 张龙 中南大学 CVD 金刚石增强铝基复合材料的制备及导热性能研究
- 110 魏秋平 中南大学 外场增强技术制备碳材料薄膜及其场发射性能的研究
- 111 陈源明 上海轩田工业设备有限公司 自动化和信息化在半导体功率器件生产中的应用
- 112 刘召军 中山大学 氮化镓基高速电子器件与发光二极管的同质集成 (HEMT-LED)
- 113 张育民 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 高质量 Ge 掺杂单晶衬底的制备